

料金表 (2026年5月31日現在)

【リソグラフィ関連装置】

装置番号	装置名	設置場所	主たる用途	消耗品費など追加料金	型番	メーカー	利用料金
19	縮小投影露光装置	(1F) フォト室	縮小露光(ステッパー)		FPA-3000i5+	キャノン	8,000円/時間
20	両面マスクアライナー	(1F) フォト室	露光(コンタクトアライナー)		MA-6	ズースマイクロテック	4,000円/時間
93	マスクレス露光装置	(1F) 材料作製室	マスクレス露光		MLA100	Heiderberg	4,000円/時間
28	スピコーター1	(1F) フォト室	レジスト塗布		DELTA80	ズースマイクロテック	2,500円/時間
29	スピコーター2	(1F) フォト室	レジスト塗布		MS-B150	ミカサ	2,500円/時間
41	スピコーター3	(1F) 材料作製室	レジスト塗布		MS-B150	ミカサ	2,500円/時間
31	ホットプレート1	(1F) フォト室	レジスト塗布		TH-900	アズワン	1,000円/時間
32	ホットプレート2	(1F) フォト室	レジスト塗布		TH-900	アズワン	1,000円/時間
110	ホットプレート3	(1F) 材料作製室	レジスト塗布		TH-900	アズワン	1,000円/時間
33	有機ドラフトチャンパー1	(1F) フォト室	現像 レジスト除去		HSS-2000	UNION	2,500円/時間
108	有機ドラフトチャンパー3	(1F) 材料作製室	現像 レジスト除去		GF1L-15TNZ	ヤマト科学	2,500円/時間
109	有機ドラフトチャンパー4	(1F) 材料作製室	現像 レジスト除去		GF1L-15TNZ	ヤマト科学	2,500円/時間
25	アッシャー1	(1F) プロセス室	レジストの除去		RP-S10	ヤマト科学	2,500円/時間
114	レーザー描画装置	(1F) 材料作製室	レーザー露光	2027年2月導入予定	DWL66+	Heiderberg	2027年2月導入予定

【イオン注入・不純物ドーピング装置】

装置番号	装置名	設置場所	主たる用途	消耗品費など追加料金	型番	メーカー	利用料金
1	イオン注入装置	(1F) プロセス室	P, B, Arのイオン注入	J1: イオン注入装置除害剤 ※PH3およびBF3ガス使用時間(分)	IMX-3500	ULVAC	6,000円/時間
73	厚膜CVD	(1F) プロセス室	PSG, BSG, BPSG成膜	J73: 厚膜CVD除害剤 ※TEOS, TMP, TEB, CF4ガス使用時間(分) s18: 再生Siウエハ ※プレでポジション利用時	PD-100ST	サムコ	4,000円/時間
28	スピコーター1	(1F) フォト室	SOG塗布		DELTA80	ズースマイクロテック	2,500円/時間
29	スピコーター2	(1F) フォト室	SOG塗布		MS-B150	ミカサ	2,500円/時間
41	スピコーター3	(1F) 材料作製室	SOG塗布		MS-B150	ミカサ	2,500円/時間

【成膜装置】

装置番号	装置名	設置場所	主たる用途	消耗品費など追加料金	型番	メーカー	利用料金
2	減圧CVD装置	(1F) プロセス室	poly-Si成膜	J2: 減圧CVD装置除害剤 ※SiH4ガス使用時間-堆積時間(分)	272-M200	光洋リンドバーグ	4,000円/時間
3	PE-CVD装置	(1F) プロセス室	SiO2, SiN, a-Si, SiON成膜	J3: PE-CVD装置除害剤 ※SiH4, NH3, CF4ガス使用時間(分) s18: 再生Siウエハ ※プレでポジション利用時	PD-200NL	サムコ	6,000円/時間
73	厚膜CVD	(1F) プロセス室	SiO2, PSG, BSG, BPSG, SiOC成膜	J73: 厚膜CVD除害剤 ※TEOS, TMP, TEB, CF4ガス使用時間(分) s18: 再生Siウエハ ※プレでポジション利用時	PD-100ST	サムコ	4,000円/時間
74	ALD装置	(1F) プロセス室	Al2O3成膜	TMA: TMAガス ※TMAガス使用回数(回) J74: 74ALD装置除害剤 ※Al2O3堆積時間(分)	Savannah S100-4PVP	ケンブリッジ	4,000円/時間
75	高速深堀RIE	(1F) プロセス室	CF系膜成膜	J75: 高速深堀RIE除害剤 ※SF6, C4F8, CHF3ガス使用時間(分) s22: 石英ウエハ(溶融石英) ※チップ貼り付け時基板	800iPB	サムコ	6,000円/時間
5	スパッタ装置2	(1F) プロセス室	各種無機材料成膜	各種ターゲット使用料金 ※成膜膜厚(10nm)単位で課金	E-200S	キャノンアネルバ	4,000円/時間
99	スパッタ装置3	(1F) プロセス室, CR	各種材料の成膜	各種ターゲット使用料金 ※成膜膜厚(10nm)単位	EB-1000	キャノンアネルバ	4,000円/時間
80	クイックコーター	(2F) マイクロ化技術室	SEM観察試料表面へのAu, Pt成膜		SC-701MK II	サンヨー電子	2,500円/時間
38	蒸着装置1	(2F) 材料作製室	各種金属膜の蒸着(抵抗加熱)	s8: 蒸着金線 s13: 蒸着アルミ線 ※使用長さ(10mm)単位で課金	E-250	島津製作所	2,500円/時間
13	高速熱処理炉1	(1F) プロセス室	熱酸化		RTP-6	ULVAC	4,000円/時間
7	電気炉1号炉	(1F) プロセス室	熱酸化(ドライ)		M200, M300	光洋リンドバーグ	4,000円/時間
8	電気炉2号炉	(1F) プロセス室	熱酸化(ドライ, ウェット)		M200, M300	光洋リンドバーグ	4,000円/時間
10	電気炉4号炉	(1F) プロセス室	熱酸化(ドライ)		M200, M300	光洋リンドバーグ	4,000円/時間
11	電気炉5号炉	(1F) プロセス室	熱酸化(ドライ)		M200, M300	光洋リンドバーグ	4,000円/時間
82	小型チューブ炉	(2F) マイクロ化技術室	熱酸化		KTF050NI	KOYO	2,500円/時間
28	スピコーター1	(1F) フォト室	レジスト・SOG・ポリイミドなどの塗布		DELTA80	ズースマイクロテック	2,500円/時間
29	スピコーター2	(1F) フォト室	レジスト・SOG・ポリイミドなどの塗布		MS-B150	ミカサ	2,500円/時間
41	スピコーター3	(1F) 材料作製室	レジスト・SOG・ポリイミドなどの塗布		MS-B150	ミカサ	2,500円/時間
116	無電解メッキ	(1F)材料作製室	Cu無電解メッキ	2026年8月導入予定			

【ドライエッチング装置】

装置番号	装置名	設置場所	主たる用途	消耗品費など追加料金	型番	メーカー	利用料金
15	Si系材料 ドライエッチング装置	(1F) プロセス室	フッ素系ガスによるドライエッチング Si, SiO2, SiNなど	J15: Si系材料ドライエッチング装置除害剤 ※CHF3, CF4, F2ガス使用時間(分) s18: 再生Siウエハ ※チップ貼り付け時基板 s22: 石英ウエハ(溶融石英) ※装置使用後のクリーニング ※チップ貼り付け時基板	RIE-101iPH (フッ素ガス仕様)	サムコ	6,000円/時間
16	Metal系材料 ドライエッチング装置	(1F) プロセス室	塩素系ガスによるドライエッチング Si, Al, Al2O3, GaN, セラミックなど	J16: Metal系材料ドライエッチング装置除害剤 ※BCl3, Cl2, F2ガス使用時間(分) s22: 石英ウエハ(溶融石英) ※装置使用後のクリーニング ※チップ貼り付け時基板	RIE-101iPH (塩素ガス仕様)	サムコ	6,000円/時間
75	高速深堀RIE	(1F) プロセス室	シリコンの深堀加工(ボッシュ)	J75: 高速深堀RIE除害剤 ※SF6, C4F8, CHF3ガス使用時間(分) s22: 石英ウエハ(溶融石英) ※チップ貼り付け時基板	800iPB	サムコ	6,000円/時間
76	XeF2エッチャー	(1F) プロセス室	シリコンの高速エッチング	XeF2: XeF2ガス ※XeF2ガス使用回数(回)	自作	自作	4,000円/時間

25	アッシャー-1	(1F) プロセス室	CF4によるシリコンの等方性エッチング		RP-510	ヤマト科学	2,500円/時間
----	---------	---------------	---------------------	--	--------	-------	-----------

【ウェットエッチング装置】

装置番号	装置名	設置場所	主たる用途	消耗品費など追加料金	型番	メーカー	利用料金
22	無機ドラフトチャンバー(HF)	(1F) プロセス室	シリコン酸化膜エッチング	BHF、BHF洗浄槽薬品 ※使用回数(回)	HSS-2000HF	ダン産業	2,500円/時間
23	無機ドラフトチャンバー(一般酸)	(1F) プロセス室	各種無機材料のエッチング		HSS-2000HF	ダン産業	2,500円/時間
50	無機ドラフトチャンバー	(2F) マイクロ化技術室	各種無機材料のエッチング				2,500円/時間
97	無機ドラフトチャンバー-2	(1F) 材料作製室	各種材料のエッチング			Dan-Takuma	2,500円/時間

【熱処理装置】

装置番号	装置名	設置場所	主たる用途	消耗品費など追加料金	型番	メーカー	利用料金
9	電気炉3号炉	(1F) プロセス室	金属材料熱処理		M200、M300	光洋リンドバーグ	4,000円/時間
10	電気炉4号炉	(1F) プロセス室	シリコンドーパント拡散		M200、M300	光洋リンドバーグ	4,000円/時間
11	電気炉5号炉	(1F) プロセス室	各種無機材料熱処理		M200、M300	光洋リンドバーグ	4,000円/時間
82	小型チューブ炉	(2F) マイクロ化技術室	各種材料熱処理		KTF050N1	KOYO	2,500円/時間
13	高速熱処理炉1	(1F) プロセス室	各種材料熱処理		RTP-6	ULVAC	4,000円/時間
31	ホットプレート1	(1F) フォト室	レジスト・SOG・ポリイミドなどの熱処理		TH-900	アズワン	1,000円/時間
32	ホットプレート2	(1F) フォト室	レジスト・SOG・ポリイミドなどの熱処理		TH-900	アズワン	1,000円/時間
110	ホットプレート3	(1F) 材料作製室	レジスト・SOG・ポリイミドなどの熱処理		TH-900	アズワン	1,000円/時間
30	クリーンオープン	(1F) フォト室	レジスト・SOG・ポリイミドなどの熱処理		DE410	ヤマト科学	2,500円/時間
83	オープン	(2F) システム化技術室	ダイボンディング後の熱処理		DX302	Yamato	1,000円/時間

【洗浄・乾燥装置】

装置番号	装置名	設置場所	主たる用途	消耗品費など追加料金	型番	メーカー	利用料金
107	ブラン洗浄装置	(1F) 材料作製室	CMP後の洗浄 各種基板の洗浄		DT-PCMP6-M	ダルトン	4,000円/時間
22	無機ドラフトチャンバー(HF)	(1F) プロセス室	シリコンウエハの洗浄	BHF、BHF洗浄槽薬品 ※使用回数(回)	HSS-2000HF	ダン産業	2,500円/時間
23	無機ドラフトチャンバー(一般酸)	(1F) プロセス室	各種基板の洗浄		HSS-2000HF	ダン産業	2,500円/時間
24	ROA洗浄槽	(1F) プロセス室	シリコンウエハの洗浄	RCA、RCA洗浄槽薬品 SPM、SPM洗浄槽薬品 ※使用回数(回)		ダルトン	2,500円/時間
50	無機ドラフトチャンバー	(2F) マイクロ化技術室	各種基板の洗浄				2,500円/時間
97	無機ドラフトチャンバー-2	(1F) 材料作製室	無機薬品洗浄			Dan-Takuma	2,500円/時間
33	有機ドラフトチャンバー-1	(1F) フォト室	有機溶剤による基板の洗浄		HSS-2000	UNION	2,500円/時間
49	有機ドラフトチャンバー	(2F) マイクロ化技術室	有機溶剤による基板の洗浄				2,500円/時間
108	有機ドラフトチャンバー-3	(1F) 材料作製室	有機溶剤による基板の洗浄		GF1L-15TNZ	ヤマト科学	2,500円/時間
109	有機ドラフトチャンバー-4	(1F) 材料作製室	有機溶剤による基板の洗浄		GF1L-15TNZ	ヤマト科学	2,500円/時間
77	超臨界乾燥洗浄装置	(2F) マイクロ化技術室	微細構造基板の乾燥		LSCRD403	隆祥産業	2,500円/時間
26	スピンドライヤー	(1F) プロセス室	4インチウエハの乾燥		SPD160RN	コクサン	2,500円/時間

【後工程装置】

装置番号	装置名	設置場所	主たる用途	消耗品費など追加料金	型番	メーカー	利用料金
54	ダイサー+マウンター	(2F) マイクロ化技術室	各種基板のダイシング		DAD322	DISCO	2,500円/時間
105	エポキシダイボンダー	(2F) システム化技術室	プリント基板へのチップ実装		7200CR	ハイソル	2,500円/時間
60	ワイヤーボンダー	(2F) システム化技術室	Au、Alワイヤーボンディング		7476D	ハイソル	2,500円/時間

【研磨・研削装置】

装置番号	装置名	設置場所	主たる用途	消耗品費など追加料金	型番	メーカー	利用料金
106	CMP装置	(1F) 材料作製室	Si、SiO <sub>2</sub> 、各種金属のCMP 各種材料表面の平坦化	s23: SiO <sub>2</sub> 研磨用スラリー s24: Cu研磨用スラリー s25: Ti研磨用スラリー s27: 高選択性SiO <sub>2</sub> 研磨用スラリー ※利用スラリー100g単位 s26: CMP部材費 ※ドレス1回単位	RDP-500	不二越機械	4,000円/時間
106	卓上研磨装置	(1F) 材料作製室	基板表面の平坦化 基板の薄化	s23: SiO <sub>2</sub> 研磨用スラリー s24: Cu研磨用スラリー s25: Ti研磨用スラリー s27: 高選択性SiO <sub>2</sub> 研磨用スラリー ※利用スラリー100g単位 s26: CMP部材費 ※ドレス1回単位	IM-P2	IMT	4,000円/時間
97	無機ドラフトチャンバー-2	(1F) 材料作製室	CMPスラリー、薬品調合			Dan-Takuma	2,500円/時間

【評価観察装置】

装置番号	装置名	設置場所	主たる用途	消耗品費など追加料金	型番	メーカー	利用料金
62	プロービングシステム	(2F) 設計開発室	トランジスタなどのデバイス電氣的評価			アジエントテクノロジー +ベクターセミコン	2,500円/時間

63	高電圧カーブトレーサ +ブローバー	(2F) マイクロ化技術室	トランジスタなどのデバイス電氣的評価(高電圧)		CS-3300	岩通 +ベクターセミコン	2,500円/時間
86	半導体パラメーターアナライザー3 +ブローバー	(2F) 設計開発室	トランジスタなどのデバイス電氣的評価		B1500A	Agilent +MICRONICS JAPAN	2,500円/時間
101	オートブローバー	(2F) システム化技術室	トランジスタなどのデバイス電氣的評価		B1500A+HSP-150	Agilent+HISOL	2,500円/時間
64	四探針測定器1	(1F) 炉体室	電気抵抗測定		Model RT-70 RG -5 +TCR	ナブソン	1,000円/時間
94	エリブソメーター	(1F) 炉体室	極薄透明薄膜の膜厚測定		LSE	ガートナ	2,500円/時間
96	膜厚測定器	(1F) 炉体室	透明薄膜の白色干渉型膜厚測定		M5000	ナノスペック	2,500円/時間
96	膜厚測定器2	(1F) 炉体室	透明材料の白色干渉型膜厚測定		FR-ES VIS/NIR	θ metrisis	2,500円/時間
104	表面形状測定器3	(1F) 炉体室	パターンの段差測定(触針式)		ET200A	小坂研究所	2,500円/時間
102	共焦点レーザー顕微鏡	(2F) マイクロ化技術室	3次元微細構造観察		VK-X3000	キーエンス	2,500円/時間
100	3次元光学顕微鏡	(1F) 材料作製室	微細構造観察(光学)		VHX-7000	Keyence	2,500円/時間
100	3次元光学顕微鏡2	(1F) フォト室	微細構造観察(光学)		VHX-X1	Keyence	2,500円/時間
84	光学顕微鏡	(1F) 材料作製室	微細構造観察(光学)		ECLIPSE	NIKON	1,000円/時間
35	光学顕微鏡2	(1F) フォト室	微細パターン観察(光学)		エクリプスL200AF	NIKON	2,500円/時間
34	DUV顕微鏡	(1F) プロセス室	微細パターン観察(光学)		INM300 DUV	KLA-Tencor	2,500円/時間
57	FIB/SEM複合装置	(2F) 状態評価室	微細パターン観察(電子)	s9: FIB-SEM FIB Gaイオン源使用 s10: FIB-SEMプラチナデポ s12: FIB-SEMカーボンデポ ※FIB使用時 ※使用時間(分)	JIB-4600F	JEOL	4,000円/時間
55	簡易SEM	(2F) マイクロ化 技術室	微細パターン観察(電子)		JCM-5700	日本電子	2,500円/時間
115	電界放出型走査電子顕微鏡(EDX)	(1F) フォト室	微細パターン観察(電子) 元素分析	2027年2月導入予定			

・使用可能時間は9:00~17:00とする。

・1回の利用あたり、30分単位で切り上げて課金

・上記時間外での利用が生じた場合には、装置利用料金x1.5倍に加え時間外管理費用(15,000円/時間)を徴収する。

品番	操作指導料・代理操作料・工程管理費用	料金
op	操作指導料	9,000円/時間
ops	代理操作	15,000円/時間
pm	工程管理費(お任せコース(委託試作)実施時)	2,200円/工程・バッチ

品番	個別講習料金	料金
Lec1	個別講習(教授)	24,000円/時間
Lec2	個別講習(准教授)	20,000円/時間
Lec3	個別講習(講師)	16,000円/時間
Lec3	個別講習(助教)	15,000円/時間

品番	CR内デジケータ利用料金	料金
u1a	A	3,200円/月
u1b	B	2,000円/月

品番	白衣更衣室ロッカー利用料金	料金
u2	白衣更衣室ロッカー	1,000円/月

品番	フォトマスク(レチクル)作製・レンタル料金	料金
998	フォトマスク(レチクル)作製	125,200円/枚
rm	テスト露光用フォトマスク(レチクル)レンタル	10,000円/日

品番	消耗品代理購入・薬品保管費	料金
sd	消耗品代理購入	実費 x 1.3 円
bk	薬品保管費	10,000円/本・月

※装置利用料金および操作指導料、代理操作料、個別講習料は、1回の利用で30分単位で切り上げし課金。

※薬品保管費用は専用で使用される場合に課金致します。

消耗品料金			
品番	品名	使用単位	単価
s1	Siウエハ	1枚	¥3,440
s2	マスクブランクス(ステッパー用5インチ)	1枚	¥17,680
s3	マスクブランクス(アライナー用5インチ)	1枚	¥3,380
s4	マスクブランクス(アライナー用4インチ)	1枚	¥3,250
s5	EBレジスト(ポジ)ZEP-520	1cc	¥3,900
s6	EBレジスト(ネガ)SAL-601	1cc	¥850
s7	マスクケース	1個	¥3,900
s8	蒸着金線	10 mm	¥2,600
s9	FIB-SEM FIB Gaイオン源使用	10分	¥590
s10	FIB-SEMプラチナデポ	10分	¥780
s11	ウエハケース	1組	¥1,970
s12	FIB-SEMカーボンデポ	10分	¥120

ε13	蒸着アルミ線	10 mm		¥10
ε14	チップトレイ	1セット		¥2,860
ε15	クリーンスーツ(M~6L)	1着		¥11,290
ε16	クリーンシューズ(23.5cm~29cm)	1足		¥12,150
ε17	チップ搬送ケース	1個		¥3,920
ε18	再生Siウエハ	1枚		¥1,790
ε19	膜厚測定用Siチップ	1チップ		¥7,460
ε20	膜厚測定用SiO2付きSiチップ	1チップ		¥11,430
ε21	膜厚測定用SiO2付き4インチウエハ	1枚		¥45,710
ε22	石英ウエハ(熔融石英)	1枚		¥6,440
ε23	SiO2研磨用スラリー	100 g		¥360
ε24	Cu研磨用スラリー	100 g		¥970
ε25	Ti研磨用スラリー	100 g		¥1,220
ε26	CMP部材費	ドレス1回		¥120
Au	スパッターターゲット	Au	10nm	¥2,220
Pt	スパッターターゲット	Pt	10nm	¥500
Ag	スパッターターゲット	Ag	10nm	¥40
Al	スパッターターゲット	Al	10nm	¥40
AlN	スパッターターゲット	AlN	10nm	¥70
Al2O3	スパッターターゲット	Al2O3	10nm	¥90
AlSi1	スパッターターゲット	AlSi(1%)	10nm	¥90
AlSi3	スパッターターゲット	AlSi(3%)	10nm	¥90
Co	スパッターターゲット	Co	10nm	¥200
Cr	スパッターターゲット	Cr	10nm	¥40
Cu	スパッターターゲット	Cu	10nm	¥30
Ge	スパッターターゲット	Ge	10nm	¥80
ITO	スパッターターゲット	ITO	10nm	¥170
Ni	スパッターターゲット	Ni	10nm	¥60
Si	スパッターターゲット	Si	10nm	¥30
SiO2	スパッターターゲット	SiO2	10nm	¥60
Ta	スパッターターゲット	Ta	10nm	¥50
Ta2O5	スパッターターゲット	Ta2O5	10nm	¥130
Ti	スパッターターゲット	Ti	10nm	¥110
TiN	スパッターターゲット	TiN	10nm	¥90
TiO2	スパッターターゲット	TiO2	10nm	¥120
W	スパッターターゲット	W	10nm	¥60
RCA	RCA洗浄槽薬品	1回		¥1,520
SPM	SPM洗浄槽薬品	1回		¥1,900
BHF	BHF洗浄槽薬品	1回		¥1,600
XeF2	XeF2ガス	1回		¥390
TMA	TMAガス	1回		¥60
J1	1.イオン注入装置除害剤	10分 (BF3, PH3)		¥60
J2	2.減圧CVD装置除害剤	10分 (SiH4)		¥350
J3	3.PE-CVD装置除害剤	10分 (SiH4, NH3, CF4)		¥1,080
J15	15.Si系材料ドライエッチング装置除害剤	10分 (CF4, CHF3, F2)		¥90
J16	16.Metal系材料ドライエッチング装置除害剤	10分 (BCl3, Cl2, F2)		¥1,020
J73	73.厚膜CVD除害剤	10分 (TEOS, TMP, TEB, CF4)		¥170
J74	74.ALD装置除害剤	10分 (TMA)		¥150
J75	75.高速深堀RIE除害剤	10分 (SF6, C4F8, CHF3)		¥550

※ 除害剤料金は指定のガスを利用した時のみ課金する

※ 1回の利用あたり、使用単位で切り上げて課金

※その他の消耗品費は、別途請求する